

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-110726

(P2002-110726A)

(43)公開日 平成14年4月12日(2002.4.12)

(51)Int.Cl.⁷
H 01 L 21/60

識別記号
3 1 1

F I
H 01 L 21/60
21/92

テ-マコト*(参考)
3 1 1 S 5 F 0 4 4
6 0 2 D
6 0 2 G
6 0 2 R
6 0 3 A

審査請求 有 請求項の数24 O.L (全 9 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2000-304708(P2000-304708)

(22)出願日 平成12年10月4日(2000.10.4)

(出願人による申告) 国等の委託研究の成果に係る特許
出願 (平成11年度新エネルギー・産業技術総合開発機構
「超高密度電子S I技術の研究開発エネルギー使用合理
化技術開発」に関する委託研究、産業活力再生特別措置
法第30条の適用を受けるもの)

(71)出願人 000004237
日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号

(71)出願人 000006013
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

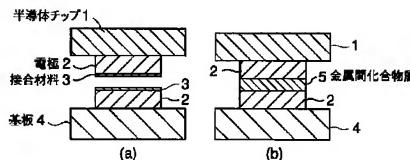
(71)出願人 000003078
株式会社東芝
東京都港区芝浦一丁目1番1号

(74)代理人 100071272
弁理士 後藤 洋介 (外1名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

(57)



(2)

1

2

10

20

30

40

50

(3)

3

4

10

20

30

40

50

(4)

5

6

10

20

30

40

50

(5)

7

8

10

20

30

40

50

(6)

9

10

10

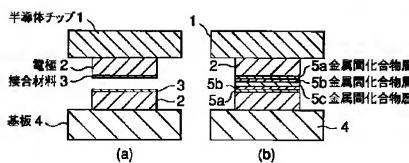
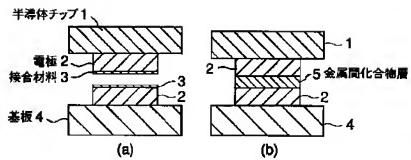
20

30

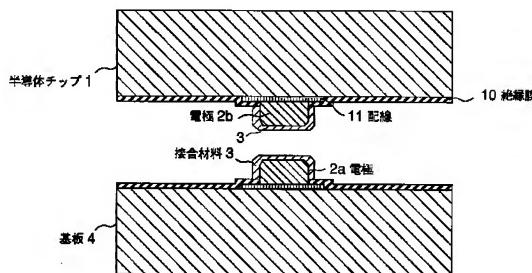
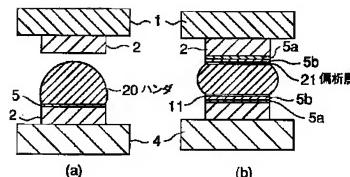
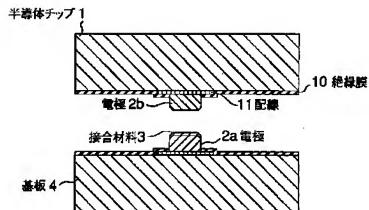
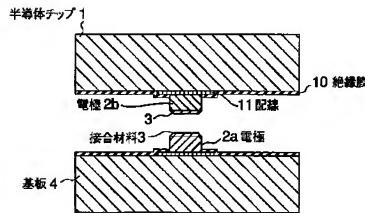
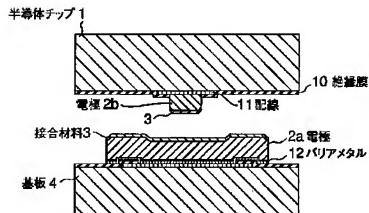
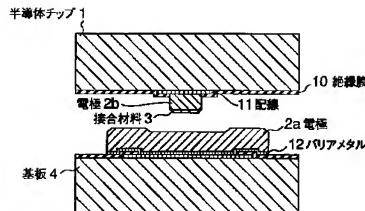
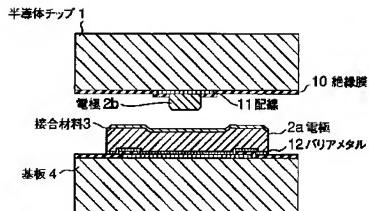
()

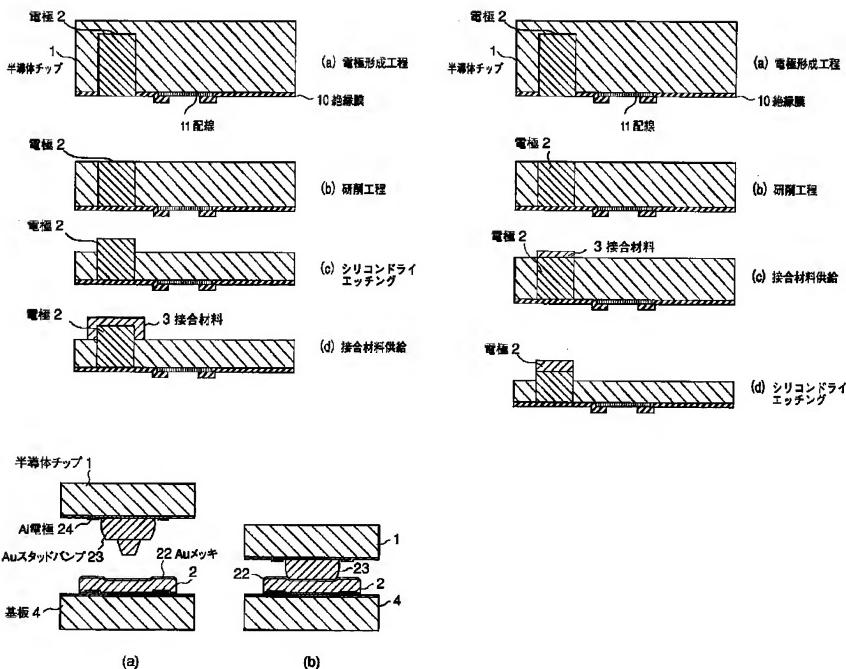
40

50



(8)





(5) Int. Q. 7

21/22

(

(72)

(72)

72

(72)

(
E044 K01 K05 KK17 KK18 KK19
1105 Q02 Q03 Q04 R02